

製品規格 / PRODUCT SPECIFICATION				DESIGNED BY	CHECKED BY	CHECKED BY	APPROVED BY				
品種名 / TYPE NUMBER : 2SC5929 [MSCS]				H. Hashimoto	K. Hidaka	Y. Yamada	S. Mizu				
種別 / Type	シリコントランジスタ / Silicon Transistor					等価回路 / Equivalent circuit					
用途 / Application	水平偏向出力用 / Horizontal Deflection Output										
構造 / Structure	NPN 三重拡散メサ型 / NPN Triple Diffused Mesa										
外形 / Out line	TOP-3D	マーク表示 / Marking	C5929								
絶対最大定格 / Absolute maximum ratings	VCBO (V)	VCES (V)	VCEO (V)	VEBO (V)	IC (A)	ICP (A)	IB (A)	PC (W)	PC (W)	Tj (°C)	Tstg (°C)
	1550	1550	600	7	12	22	5.5	50	3	150	-55~+150
電気的特性 / Electrical characteristics				測定条件 / Measure condition (Tc=25±3°C)							
項目 / ITEM	記号 / Symbol	試験条件 / Test conditions	typ.	Limit		Unit					
				min	max						
コレクタ遮断電流 Collector cut-off Current	ICBO	VCB=1000V, IE=0			50	μA					
コレクタ遮断電流 Collector cut-off Current	ICBO	VCB=1550V, IE=0			1	mA					
エミッタ遮断電流 Emitter cut-off Current	IEBO	VEB=7V, IC=0			50	μA					
直流電流増幅率 D.C. Current Gain	hFE	VCE=5V, IC=6A			6	10					
コレクタ飽和電圧 Saturation Voltage	VCE(sat)	IC=6A, IB=1.5A			2.5	V					
エミッタ飽和電圧 Saturation Voltage	VBE(sat)	IC=6A, IB=1.5A			1.5	V					
トランジション周波数 Transition Frequency	fT	VCE=10V, IC=0.1A, f=0.5MHz	3			MHz					
コレクタ電流下降時間 Fall Time	tf	IC=6A, R-loaded			0.2	μsec					
蓄積時間 Storage Time	tstg	IB1=1.5A, IB2=-3.0A			2.7	μsec					
<p>Note: 測定方法 : 日本工業規格 JIS C 7030 トランジスタ測定方法による。 Measuring Methods are based on JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD JIS C 7030 Measuring methods for Transistors.</p> <p>*1 Tc = 25°C</p> <p>*2 Ta = 25°C (放熱板無し / Without heat sink)</p> <p>*3 非繰り返し尖頭値 / Non-repetitive peak collector current.</p>											
2003.1.20											